

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
6. Februar 2014 (06.02.2014)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2014/019788 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation:
C30B 13/20 (2006.01) *C30B 35/00* (2006.01)
C30B 13/30 (2006.01)
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2013/063825
- (22) Internationales Anmeldedatum:
1. Juli 2013 (01.07.2013)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
10 2012 213 715.7
2. August 2012 (02.08.2012) DE
- (71) Anmelder: **SILTRONIC AG** [DE/DE]; Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München (DE).
- (72) Erfinder: **RAMING, Georg**; Simbacher Str. 54, 84367 Tann (DE). **ALTMANNSHOFER, Ludwig**; Kyreinweg 1a, 83661 Lengries (DE).
- (74) Anwälte: **STAUDACHER, Wolfgang** et al.; Siltronic AG, Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DEVICE FOR PRODUCING A MONOCRYSTAL BY CRYSTALLIZING SAID MONOCRYSTAL IN A MELTING AREA

(54) Bezeichnung : VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINES EINKRISTALLS DURCH KRISTALLISIEREN DES EINKRISTALLS AN EINER SCHMELZENZONE

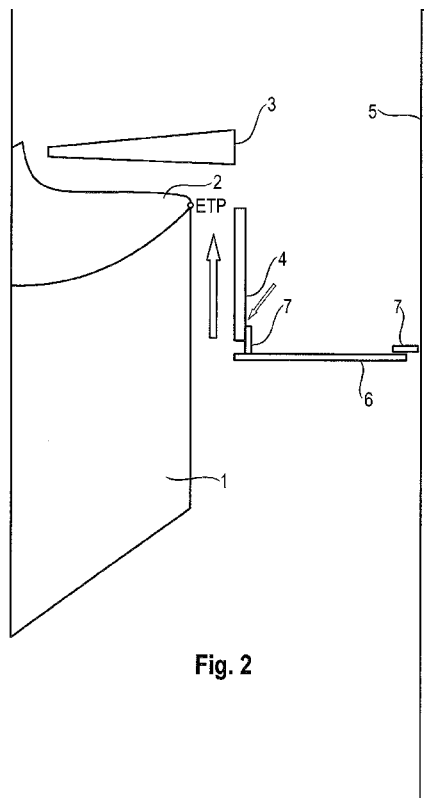


Fig. 2

(57) Abstract: The invention relates to a device for producing a monocrystal by crystallizing said monocrystal in a melting area. Said device comprises a housing, an inductor for producing heat in the melting area, an after heater which surrounds the crystallizing monocrystal and subjected to heat radiation, also comprising a separating base which defines in a downward manner, on a lower end of the after heater, an intermediate space between the after heater and a wall of the housing.

(57) Zusammenfassung: Vorrichtung zur Herstellung eines Einkristalls durch Kristallisieren des Einkristalls an einer Schmelzenzone, umfassend ein Gehäuse, einen Induktor zum Erzeugen von Wärme in der Schmelzenzone, einen Nachheizer, der den kristallisierenden Einkristall umgibt und mit Wärmestrahlung beaufschlagt, und einen Trennboden, der einen Zwischenraum zwischen dem Nachheizer und einer Wand des Gehäuses an einem unteren Ende des Nachheizers nach unten hin begrenzt.



CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD,
TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)